



主要特点

通带频率: 4 - 20 GHz

通带损耗: ≤ 2.6 dB @ 4 GHz

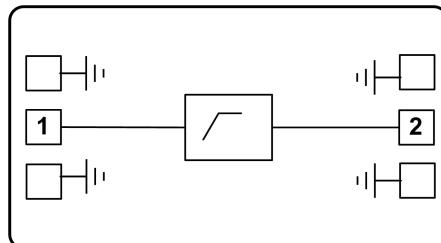
阻带衰减: ≥ 24 dB @ 3.3 GHz

≥ 31 dB @ 3.2 GHz

回波损耗: 15 dB

芯片尺寸: $1.0 \times 0.85 \times 0.1$ mm³

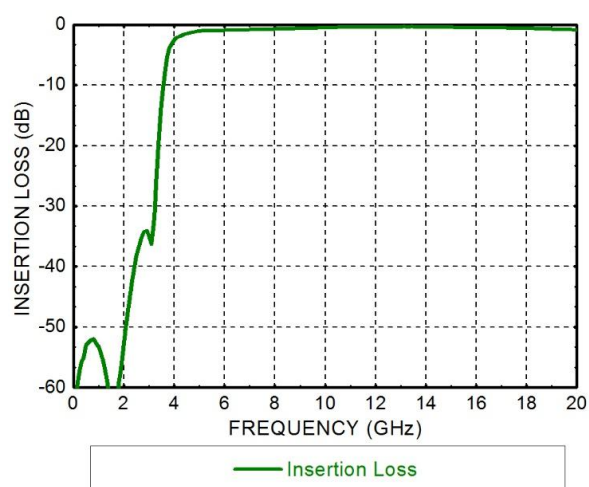
功能框图



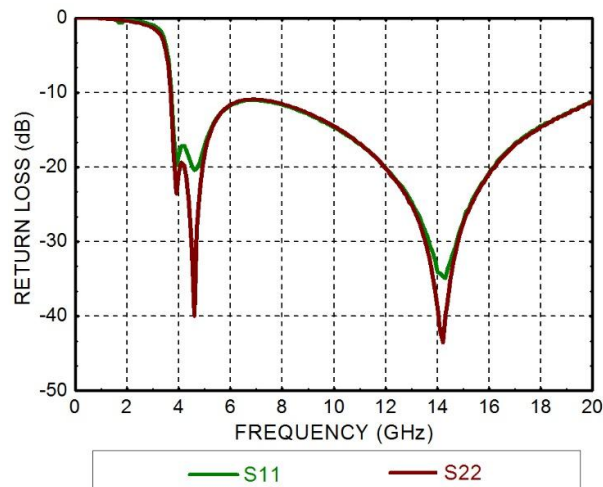
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	4 - 20			GHz
插入损耗		2.6		dB
阻带衰减 @ 3.3 GHz		24		dB
阻带衰减 @ 3.2 GHz		31		dB
回波损耗		15		dB

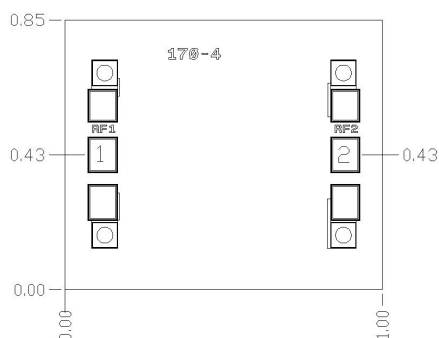
插入损耗



回波损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C